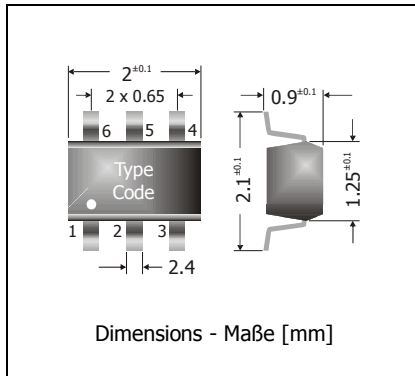


## BAV70DW

### Fast Switching Surface Mount Planar Diodes – Dual Common Cathode Schnelle Planar-Dioden für die Oberflächenmontage – Zweimal gemeinsame Kathode

Version 2015-05-28



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOT-363
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



#### Maximum ratings (T<sub>A</sub> = 25°C)

#### Grenzwerte (T<sub>A</sub> = 25°C)

		MMBD4448SDW	
Power dissipation – Verlustleistung		P <sub>tot</sub>	350 mW <sup>1)</sup>
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)		I <sub>FAV</sub>	200 mA <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I <sub>FRM</sub>	450 mA <sup>1)</sup>
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t <sub>p</sub> ≤ 1 μs t <sub>p</sub> ≤ 1 ms t <sub>p</sub> ≤ 1 s	I <sub>FSM</sub> I <sub>FSM</sub> I <sub>FSM</sub>	4 A 1 A 0.5 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V <sub>RRM</sub>	100 V
Reverse voltage – Sperrspannung		V <sub>R</sub>	100 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T <sub>j</sub>	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>S</sub>	-55...+150°C

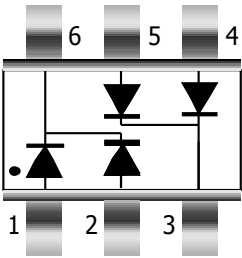
#### Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)

#### Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)

Forward voltage <sup>2)</sup> Durchlass-Spannung <sup>2)</sup>	I <sub>F</sub> = 1 mA I <sub>F</sub> = 10 mA I <sub>F</sub> = 50 mA I <sub>F</sub> = 150 mA	V <sub>F</sub> V <sub>F</sub> V <sub>F</sub> V <sub>F</sub>	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C V <sub>R</sub> = 80 V V <sub>R</sub> = 25 V	I <sub>R</sub> I <sub>R</sub>	< 500 nA < 30 nA
	T <sub>j</sub> = 150°C V <sub>R</sub> = 85 V V <sub>R</sub> = 25 V	I <sub>R</sub> I <sub>R</sub>	< 100 μA < 30 μA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V <sub>R</sub> = 0 V, f = 1 MHz		C <sub>T</sub>	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I <sub>F</sub> = 10 mA über/through I <sub>R</sub> = 10 mA bis/to I <sub>R</sub> = 1 mA		t <sub>rr</sub>	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R <sub>thA</sub>	< 625 K/W <sup>1)</sup>

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses t<sub>p</sub> = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t<sub>p</sub> = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
	<p>Fast Switching Diodes Schnelle Dioden</p> <p>1 = A1, 2 = A2, 3 = C3/C4 4 = A3, 5 = A4, 6 = C1/C2</p>	<p>BAV70DW = A4</p>

